19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60 - 195957

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

リードフレーム

20特 頤 昭59~50939

顧 昭59(1984)3月19日 **29**HH

73発

谷川 太 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

砂発 明 者

洋

小平市上水本町1450番地 株式会社日分製作所武蔵工場内

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の代理

弁理士 高橋 明夫

外1名

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

1. 偏面に突出部を設けて成ることを特象とする リードフレーム。

2. 前記リードフレームがプラスチックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

[技術分野]

本発明はリードフレームに関し、作に、モール ドレジンとの密着性を良くし、剣止性のよい樹脂 對止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に 示すごときものが周知である(工業調査会刊「IC 化奥藝技術」P137~P150など)。第1.個に て、1は半導体チップをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3 仕半導

体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電板及 び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レ **ジン)を周知のトランスファーモールド法などに** より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして側脂封止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂封止磁半導体装置にあっ 'ては、リードフレームとレジンとの密着性を良好 にし、對止性(耐運性)を向上させ、信頼度を向 上させることが必要であり、近時は半導体チップ の大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなっており、 これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使 用されるリードフレームにあっては、その側面が フラット化構成されており、リードフレームとレ グンとの審着性が不足し、對止性、信頼度の向上 という面で問題があることがわかった。

[発明の目的]

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性を向上し、信頼度の高い樹脂封止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および森付図面からあき らかになるであろう。

[発明の概要]

本顧において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 設付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面積増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの温気等の浸透性異物の侵入 の半導体チップへの到遠時間を長くして、剣止性 を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

〔突旋例〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの、要部斜視図、 第3回は第2回I-I級断面図を示す。

これら図において、4は半導体チャブを搭載するためのタップ・トドルクである。本発明 リード、6はリード、6はリード、7は機能へである。本発明 リードアルドルクでなり リードアルドルクでは、これらして、クブイト・タブルドルクでは、これの一人では、カートの実力では、カードアルクによりでは、カードアルクにより押圧してもよりでは、カードアルグにより押圧してもよいののでは、カードアルグにより押圧してもよいののでは、カードアルグにより押圧してもより形成された。このでは、カードアルグにより押圧してもより形成となった。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂對止型半導体整置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チャブ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂對止体、12はリードフレームで半導体チャブ9を搭載しているタブ13、及び半導体チャブ9の内部配盤をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の回路案子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路案子は例えば、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路案子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(A8)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキン樹脂により 成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の関係で横方向に複数の線条の溝部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような機能對止型半導体装置において、半導体チップ9が大形化し、リード14を側間対止体11に掴込まれる長さが次額に短くなって第4図に示すような折曲げリードとする場合、折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンからスリップし、リードが関節対止体外部によけいに引っぱり出されることになる。かかる溝部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

(効果)

(1) リードフレームの切断面に設付けを行ない、 側面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られる。

(2) 着面積の増大により、レジン量が増大し、

17

かつ、側面がフラットである 合化比較して、段 が形成されているのでリークパスが長くなり、そ の結果外部からの半導体装置内部への浸透性異物 の侵入が遅くなり對止性(耐癌性)が向上する。 (3) リードフレームとレジンとの密着性。對止性 の向上により製品寿命を延命し、樹脂對止型半導 体装置の信頼性を着しく向上することができる。 (4) 半導体チップが大型化し、リードのモールド レジン中へ組め込まれている部分が増々短くなっ ている今日、リードフレームに良付けを行い、リ ードフレームとレジンとの密着性の向上の殴り、 對止性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し得 ることは工業上極めて有意義である。

(5) リードフレームの側面に突出部を設けること に加えて、第5回に示すように、リードの上面に 講部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの密着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に襲し、リードがゆるん だり、樹脂對止体の外部に突出したりすることを 防止できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に説明したが、本苑明は上配実施 例に限定されるものではなく、その要旨は逸脱し ない範囲で種々変更可能であることはいうまでも たい。

例之ば、前記実施例では、リードフレーム側面 金体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支えない。又前配実施例では講部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。 [利用分野]

本発明はデェアルインライン(DIL)タイプのパ ッケージの他、フラットパックタイプのパッケージ など他の機能対止型半導体装置にも適用すること ができ、樹脂對止型半導体装置全般に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。

第1回はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2図は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3回は第2回I-I藤断面図、

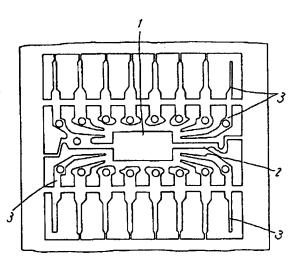
図面の簡単な説明 :

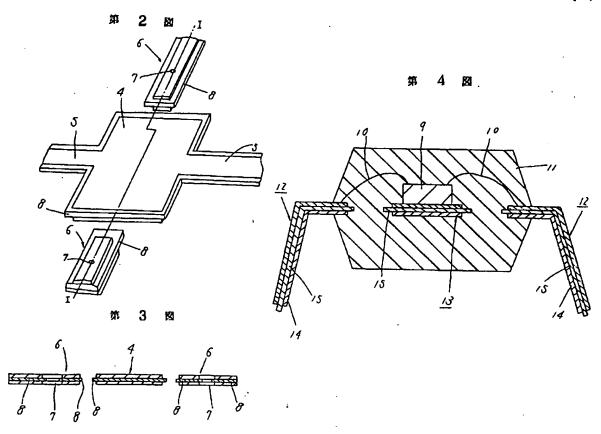
焦4図は本発明リードフレームを使用して成る 樹脂對止型半導体装置の断面図、

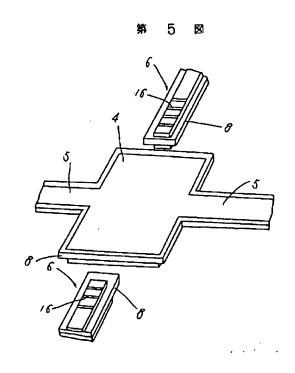
第5図は本発明の他の実施例を示すリードフレ

1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、 4 …タブ、5 …タブ吊ザリード、6 …リード、7

- 9 …半導体デップ、10
- ...コネクタワイヤ、11…樹脂對止体、12… | badfaml
- ードフレーム、13…タブ、
- …突出部、16…精部。







Abstract of Japanese Patent Office Gazette

No. H6-140563

SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor:

Tsuji Masahiro

Applicant:

Rohm Co., Ltd.

Filed:

Oct. 23, 1992

Disclosed:

May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.